

<プレスリリース>

2017年6月14日  
GLOBALFOUNDRIES Inc.

## GLOBALFOUNDRIES の 7LP 7nm FinFET テクノロジーの提供が順調に進行

**新しい 7LP テクノロジーは 14nm FinFET と比較して 40 パーセントの性能向上を提供**

GLOBALFOUNDRIES (以下 GF) は、プレミアム・モバイル・プロセッサ製品、クラウド・サーバやネットワークング・インフラストラクチャなどのアプリケーションでの性能要求を満たすために基本性能を 40 パーセント向上させた、7LP (7nm Leading-Performance) FinFET 半導体テクノロジーの提供開始を発表しました。設計キットも提供可能です。7LP をベースとした最初のカスタム製品は、2018 年前半に発表、2018 年後半には量産開始予定です。

2016 年 9 月、GF は他に例のない、自社の高性能チップ製造の実績を活用した自社の 7nm FinFET テクノロジーを開発する [計画を発表](#) しました。トランジスタとプロセスレベルの両方でのさらなる向上により、7LP テクノロジーは当初の目標を上回る性能を達成するとともに、これまでの 14nm FinFET テクノロジーと比較して、40 パーセントを超える処理能力と 2 倍のエリア・スケールングを提供すると予測されています。7LP テクノロジーは、米国ニューヨーク州サラトガ郡の最先端製造施設「Fab 8」で、お客様の各種の設計向けの準備が完了しています。

GF の CMOS 事業部シニア・バイス・プレジデントの [Gregg Bartlett](#) は次のように述べています。「GF の 7nm FinFET テクノロジーの開発は順調に進み、お客様からの強力な引き合いがあり、複数のプロダクトテープアウトを 2018 年に計画しています。そして、GF は 7nm テクノロジーの商用化を促進するとともに、お客様にワールドクラスの最先端のロードマップを確実に提供するため、5nm やそれ以下の次世代テクノロジーを積極的に開発しています」

また、GF は次世代テクノロジーノードにおける研究開発への投資も継続し行っています。GF は同社のパートナーである IBM や Samsung との緊密なコラボレーションによって、7nm テスト・チップを 2015 年に [発表](#) し、それに続き業界初のシリコン・ナノシート・トランジスタを用いた 5nm チップの動作のデモンストレーションを [最近発表](#) しました。GF はお客様のコネクテッド・インテリジェンスの次の世代を実現させるため、様々な新しいトランジスタ・アーキテクチャを研究しています。

GF の 7nm FinFET テクノロジーは、2016 年初めより Fab 8 で生産を開始した自社の 14nm FinFET テクノロジーの量産の経験を活用しています。以後、GF は数々の「最初から動作する (first-time-right)」設計を幅広いお客様に供給しています。

GF では 7LP の製造時の立ち上げを加速するために、2017 年後半に最初の EUV リソグラフィ・ツール 2 種類の追加をはじめ、新しいプロセス機器の性能に投資しています。7LP の初期の製造立ち上げは光リソグラフィをベースとして行い、量産準備が可能になり次第、EUV リソグラフィ技術に移行する予定です。

<お客様およびパートナー各社からのコメント>

AMD テクノロジ・アンド・エンジニアリング担当 CTO 兼シニア・バイス・プレジデント

**Mark Papermaster 氏**

「GF が提供する最先端の 7nm プロセステクノロジーに大変満足しています。当社と GF の協業は、より実体験のように感じ、直感的なコンピューティング体験を促進する、高性能製品の開発にフォーカスしています」

**Moor Insights & Strategy プレジデント兼首席アナリスト Patrick Moorhead 氏**

「トランジスタのジオメトリも、テクノロジーが成功するための重要なファクタのひとつです。これは 7nm 半導体の量産へのファブの重要な通過点の一つであり、GF のプロセスが、お客様の実際の製品設計を開始可能なレベルまで十分に成熟していることを示しています。GF は同時に、5nm やそれ以下のスケールの提供へ着実に歩を進めています。この種の最先端の革新を促進できるのは世界でも一握りの会社だけです。GF は明らかに、この先進的なグループの一員として、重要な役割を果たしています」

**VLSI Research CEO 兼会長 Dan Hutcheson 氏**

「GF は、先進テクノロジーにおける米国のリーダーシップを実証し続けています。もし GF が、7nm でもこの進歩を継続すれば、フル・ノードへ一足飛びに移行する初の会社になります。過去、これに挑戦したすべての会社が、プロセスのここに到る前に失敗しています。これはムーアの法則から価値を抽出するための、完全に新しい戦略的手法です。他社は、自社リソースを分割したために、ハーフノードやクォーターノードをを活用しようとしていますが、GF は 10nm に対応しない選択を行って、7nm に真正面から挑戦するための技術的なリソースを確保しました」

### **GLOBALFOUNDRIES について**

グローバルファウンドリーズは世界の優れたテクノロジー企業に向けて独自の設計、開発、製造サービスをユニークに組み合わせて提供するフルサービスの半導体ファウンドリーです。3大陸にわたり世界的な製造拠点をもち、業界を刷新する技術とシステムをご提供することにより、お客様の市場における優位性確保をお手伝いします。グローバルファウンドリーズはムバダラ・ディベロップメント・カンパニーが所有しています。詳細に関しては <http://www.globalfoundries.com> をご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

GLOBALFOUNDRIES Inc. 広報代理

アリソン・アンド・パートナーズ株式会社（担当：名倉・多賀・大塚）

TEL: 03-6809-1300 E-mail: GF\_pr\_tokyo@allisonpr.com

※紙面、web 上等のご掲載はお控えいただきますようお願いいたします。